

Jan 25
2012

Waseda Diamond International Workshop 早稲田ダイヤモンド国際ワークショップ

ダイヤモンド半導体のパワーデバイス開発が進展している。JSTではALCA「大口径ダイヤモンド基板によるグリーンインバータ基礎技術（早大、東工大）」、CREST「超低損失パワーデバイス実現のための基盤構築（産総研）」が展開されている。今回、外国からの招聘者を含め、パワーデバイス開発にかかわる数々の課題について議論を行うためのワークショップを開催する。

場所：早大理工キャンパス 63号館2階 05会議室
<http://www.waseda.jp/jp/campus/nishiwaseda.html>
日時：1月25日（水）13:00-17:30（続いて懇親会）

- | | |
|-------------|--|
| 13:00-13:20 | H. Kawarada (Waseda University)
"Diamond power electronics" |
| 13:20-13:40 | S. Yamasaki (AIST)
"Recent progress in diamond bipolar devices research" |
| 13:40-14:00 | M. Hatano, (Tokyo Institute of Technology)
"Core Technologies for Diamond Power Devices" |
| 14:00-14:20 | S. Koizumi (NIMS)
"n-Type diamond and pn junction researches at NIMS" |
| 14:20-14:40 | Break I |
| 14:40-15:10 | J. Pernot (Institut Neel – CNRS) (invited)
"Electrical properties of boron doped diamond for power device applications" |
| 15:10-15:30 | T. Teraji (NIMS)
"Research issues of diamond Schottky barrier junction" |
| 15:30-15:50 | T. Makino (AIST)
"Electron-hole recombination in diamond bipolar devices" |
| 15:50-16:10 | Break II |
| 16:10-16:40 | K. Haenen (Hasselt University) (invited)
"((100) Homoepitaxial CVD diamond films: Growth and carrier transport" |
| 16:40-17:00 | A. Sawabe (Aoyama Gakuin University)
"Hetero-epitaxial growth of diamond" |
| 17:00-17:30 | Roll-up discussion |
| 18:00- | Banquet |

